(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 20 juin 2002 (20.06.2002)

PCT

(72) Inventeurs; et

(10) Numéro de publication internationale WO 02/48691 A1

MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31/33, rue de la Fédération, F-75752 PARIS 15ème (FR).

Françoise [FR/FR]; 22, boulevard Edouard Rey, F-38000

GRENOBLE (FR). BARRITAULT, Pierre [FR/FR]; 54, rue de Stalingrad, F-38100 GRENOBLE (FR). GETIN,

Stéphane [FR/FR]; 10, impasse des Sablons, F-38120

(74) Mandataire: LEHU, Jean; c/o BREVATOME, 3, rue du

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : COM-

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): CHATON, Patrick [FR/FR]; Loutre, F-38570 THEYS (FR). VINET,

(51) Classification internationale des brevets7:

G01N 21/64

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR01/03960

(22) Date de dépôt international :

12 décembre 2001 (12.12.2001)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

(30) Données relatives à la priorité :

00 16317

14 décembre 2000 (14.12.2000)

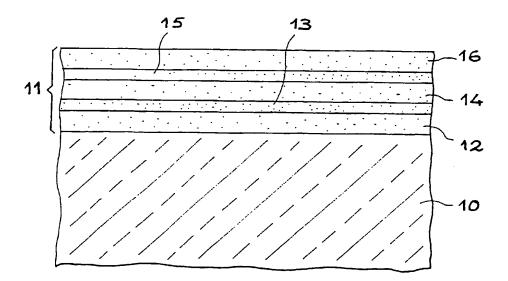
- français
- Docteur Lancereaux, F-75008 PARIS (FR).
- (81) États désignés (national): JP, US.

SAINT-EGREVE (FR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DEVICE FOR ENHANCING WIDEBAND FLUORESCENCE WITH LOW LOSSES AND BIOLOGICAL OR CHEM-ICAL OPTICAL SENSOR USING SAME

(54) Titre: DISPOSITIF DE RENFORCEMENT DE FLUORESCENCE LARGE BANDE A FAIBLES PERTES ET CAPTEUR OPTIQUE BIOLOGIQUE OU CHIMIQUE L'UTILISANT.



(57) Abstract: The invention concerns a device for enhancing fluorescence comprising a support (10) supporting fluorescence enhancing means (11), the fluorescence enhancing means providing a surface for receiving chemical or biological elements to be read by detection of a fluorescence signal emitted by a fluorophore, associated with the chemical or biological elements, under the effect of an excitation light beam. The fluorescence enhancing means (11) consist of a thin transparent dielectric layer or a stack of thin transparent dielectric layers (12 to 16) ensuring a mirror function for the fluorescence signals and for the excitation light beam, the material of the thin layer or of each thin layer of the stack being selected among the following materials: TiO2, Ta2O5, HfO62, 2027, MgO, SiO₂, Si₃N₄, MgF₂, YF₃. The invention is applicable to a biological or chemical optical sensor.

[Suite sur la page suivante]

WO 02/48691 A1



(84) États désignés (régional): brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) Abrégé: L'invention concerne un dispositif de renforcement de fluorescence comprenant un support (10) supportant des moyens de renforcement de fluorescence (11), les moyens de renforcement de fluorescence offrant une face de réception pour des éléments chimiques ou biologiques destinés à être lus par détection d'un signal de fluorescence émis par un fluorophore, associé aux éléments chimiques ou biologiques, sous l'effet d'un faisceau lumineux d'excitation. Les moyens de renforcement de fluorescence (11) sont constitués par une couche mince diélectrique transparente ou un empilement de couches minces diélectriques transparentes (12 à 16) assurant une fonction miroir pour le signal de fluorescence et pour le faisceau lumineux d'excitation, le matériau de la couche mince ou de chaque couche mince de l'empilement étant choisi parmi les matériaux suivants : TiO2, Ta205, HfO2, ZrO2, MgO, SiO2, Si3N4, MgF2 et YF3.

DISPOSITIF DE RENFORCEMENT DE FLUORESCENCE LARGE BANDE A FAIBLES PERTES ET CAPTEUR OPTIQUE BIOLOGIQUE OU CHIMIQUE L'UTILISANT

5

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

L'invention concerne un dispositif de renforcement de fluorescence large bande à faibles pertes. Elle concerne aussi un capteur optique 10 biologique ou chimique utilisant un tel dispositif de renforcement de fluorescence.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

La détection de réactions chimiques ou biologiques sur un support solide par marquage fluorescent est rendue difficile par les faibles niveaux de signal émis par les fluorophores.

Il existe deux méthodes permettant de 20 renforcer le signal émis par les fluorophores. Elles sont basées sur l'exacerbation du champ excitateur par des ondes évanescentes. Ces méthodes impliquent l'utilisation de scanners dédiés. Du fait de leurs principes de fonctionnement avec des modes guidés, ces 25 méthodes ne sont pas large-bande. L'excitation doit s'effectuer une condition de avec résonance bien déterminée.

Le document "Sensivity enhancement of optical immunosensors by the use of a surface plasmon 30 resonance fluoroimmunoassay" de F.W. ATTRIDGE et al., Biosensors & Bioelectronics, vol. 6, 1991, page 201 à

10

15

20

25

30

214, divulque une méthode de renforcement de fluorescence basée sur les plasmons de surface. Cette méthode consiste à déposer sur le biocapteur, entre le substrat et la couche contenant les éléments chimiques ou biologiques, une couche mince métallique (d'argent par exemple) recouverte par une couche de silice. Le biocapteur est placé sur une lentille hémi-sphérique (ou un prisme). Le faisceau d'excitation traverse ce composant et arrive sur la couche d'argent de telle manière que des plasmons de surface soient générés. Ce phénomène crée un champ excitateur intense qui permet l'émission d'exacerber en fluorescence. Malheureusement, l'emploi d'une couche mince métallique l'existence de pertes radiatives implique non préjudiciables au renforcement de fluorescence.

Le document "Slab Wavequides in Chemistry "de L. KANG et al., Critical Reviews in Analytical 21, N° 6, 1990, pages 377 Chemistry, vol. divulque une méthode de renforcement de fluorescence basée sur l'optique guidée. Cette méthode consiste à déposer sur le biocapteur, entre le substrat et la couche contenant les éléments chimiques ou biologiques, une structure guidante. Par un dispositif de couplage approprié (prisme, réseau) la lumière est injectée dans réflexion de la lumière quidée quide: La l'interface quide/milieu contenant les fluorophores crée une onde évanescente dans le milieu contenant les fluorophores. Cette onde évanescente crée surintensité qui permet d'exciter le fluorophore de telle manière qu'il émet une quantité importante de lumière. .

10

15

Ces deux méthodes permettent donc d'augmenter le signal de fluorescence. Cependant, comme il a été dit plus haut, ces méthodes impliquent l'utilisation de scanners. Ces méthodes ne sont pas large-bande.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

L'objectif de l'invention est de renforcer la fluorescence par des ondes classiques (propagatives), ce qui permet une lecture du signal de fluorescence par des instruments commerciaux. Il s'agit de plus d'élargir les possibilités de renforcement de fluorescence en utilisant un composant fonctionnant sur une bande spectrale large. Il s'agit enfin de limiter les pertes non radiatives dues aux imperfections des matériaux employés.

La technique de détection proposée par l'invention est basée sur le dépôt d'un empilement de couches minces optiques réalisant une fonction miroir à faibles pertes non radiatives.

20 Un premier objet de l'invention consiste en un dispositif de renforcement de fluorescence comprenant un support supportant des moyens de renforcement de fluorescence, les moyens de renforcement de fluorescence offrant une face de. 25 réception pour des éléments chimiques ou biologiques destinés à être lus par détection d'un signal fluorescence émis par un fluorophore, associé aux éléments chimiques ou biologiques, sous l'effet d'un faisceau lumineux d'excitation, caractérisé en ce que 30 de renforcement de les moyens fluorescence constitués par une couche mince diélectrique

20

25

empilement de couches minces un transparente ou diélectriques transparentes assurant une fonction miroir pour le signal de fluorescence et pour lumineux d'excitation, le matériau de faisceau couche mince ou de chaque couche mince de l'empilement étant choisi parmi les matériaux suivants : TiO2, Ta2O5, HfO2, ZrO2, MqO, SiO2, Si3N4, MgF2 et YF3.

L'épaisseur e de la couche mince ou l'épaisseur de chaque couche mince de l'empilement peut être calculée à partir de la formule suivante :

N.e =
$$k.\lambda/4$$

où N est l'indice de réfraction du matériau de couche mince pour la longueur λ du signal de lecture et k est un entier impair.

Eventuellement, les moyens de renforcement de fluorescence sont des moyens déposés sur une face structurée du support.

Selon les applications, ladite face de réception peut être une face offrant des fonctions hydroxyles ou une face offrant des fonctions aldéhydes.

Un deuxième objet de l'invention consiste en un capteur optique biologique ou chimique constitué par le dispositif décrit ci-dessus, ladite face de réception supportant des éléments chimiques ou biologiques marqués par un fluorophore.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages et particularités apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre

d'exemple non limitatif, accompagnée des dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe transversale d'un capteur optique selon la présente invention,

- la figure 2 est une vue en coupe transversale d'un dispositif de renforcement de fluorescence selon la présente invention.

10 DESCRIPTION DETAILLEE DE MODES DE REALISATION DE L'INVENTION

La figure 1 est une vue en coupe transversale d'un capteur optique, biologique chimique, selon la présente invention. Elle représente un substrat 1 supportant des moyens de renforcement de 15 fluorescence 2 qui supportent à leur substances chimiques ou biologiques marquées par un fluorophore. Ces substances sont représentées sous la forme d'une couche 3.

On a représenté sur cette figure une lentille de focalisation 4 et un faisceau de lecture 5 pour symboliser le système de lecture et d'excitation par microscopie en épifluorescence.

Les moyens de renforcement de fluorescence 25 2 peuvent être constitués par un empilement de couches minces diélectriques. Ces couches minces peuvent être constituées à partir des matériaux suivants : TiO₂, Ta₂O₅, HfO₂, ZrO₂, MgO, SiO₂, Si₃N₄, MgF₂ et YF₃. Ces matériaux peuvent être déposés par des techniques de 30 type PVD (canon à électrons, pulvérisation.), par des techniques de type CVD ou par dépôt sol-gel.

15

25

Ces moyens de renforcement de fluorescence sous forme de couches minces peuvent être déposés sur l'ensemble du substrat ou sur un substrat structuré. Dans ce dernier cas, ils peuvent être localisés par des techniques classiques de lithographie, de "lift off" ou de masquage mécanique. Dans tous les cas, la stoechiométrie des matériaux doit être parfaitement maîtrisée. Un soin particulier est apporté à la dernière couche pour éviter la création de pertes non radiatives.

La dernière couche mince doit présenter une compatibilité biologique avec les sondes à greffer sur cette couche. La silice ou le nitrure de silicium présentent cette qualité de compatibilité biologique.

Les moyens de renforcement de fluorescence assurent une fonction miroir pour la longueur d'onde d'excitation. Pour cela, il suffit que les épaisseurs optiques des différentes couches minces suivent la règle suivante :

$$N.e = k.\frac{\lambda}{4}$$
 (1)

N étant l'indice de réfraction du matériau considéré à la longueur d'onde d'excitation, k étant un nombre entier impair, λ la longueur d'onde d'excitation et e l'épaisseur optique de la couche considérée. On entend par "épaisseur optique" le produit de l'indice de réfraction avec l'épaisseur mécanique de la couche mince pour la longueur d'onde considérée.

On va maintenant décrire la réalisation d'un dispositif de renforcement de fluorescence pour

une biopuce à ADN, ce dispositif étant optimisé pour le fluorophore CY3.

La figure 2 montre, en coupe transversale, un tel dispositif. Sur un substrat 10 en silicium, les moyens de renforcement de fluorescence 11 ont été déposés sous la forme de cinq couches référencées 12 à 16. Ce dispositif est prévu pour une longueur d'onde d'excitation du fluorophore CY3 d'environ 550 nm

Les couches 12, 14 et 16 sont en SiO₂,
10 d'indice de réfraction 1,46 pour la longueur d'onde
d'excitation considérée. Les couches 13 et 15 sont en
Si₃N₄, d'indice de réfraction 2 pour la longueur d'onde
d'excitation considérée.

En appliquant la règle (1) ci-dessus, on obtient, pour k=1, une épaisseur mécanique de 94 nm pour chaque couche de SiO_2 et une épaisseur mécanique de 69 nm pour chaque couche de Si_3N_4 .

Avec cet empilement de couches, la largeur de bande disponible pour l'excitation est de + ou - 20 100 nm autour de la longueur d'onde de centrage de 550 nm. Il est donc compatible à la fois pour le fluorophore CY3 et le fluorophore CY5.

Pour la lecture en fluorescence, on peut utiliser un microscope optimisé pour CY3. Il est doté d'un filtre optique de sélection de la lumière d'excitation à 546 nm pour une largeur spectrale de 10 nm environ.

Les couches de SiO_2 peuvent être déposées par un procédé de type CVD à $800\,^{\circ}$ C. Les couches de Si_3N_4 30 peuvent être déposées par un procédé de type CVD à $730\,^{\circ}$ C.

25

15

20

25

30

Les moyens de renforcement de fluorescence peuvent ne comporter qu'une seule couche, par exemple une couche de SiO_2 d'épaisseur mécanique 500 nm.

On va maintenant décrire quelques étapes de 5 greffage et d'hybridation sur le dispositif de renforcement de fluorescence selon l'invention.

Un premier exemple concerne le greffage d'oligonucléotides in situ. La face libre des moyens de renforcement de fluorescence est traitée par voie chimique pour obtenir des fonctions hydroxyles surface. Le dispositif fonctionnalisé est ensuite synthétiseur automatique introduit dans un d'oligonucléotides (Expedite 8909, PE Biosystems) qui croître faire base par base un permet 3 ¹ oligonucléotide de 20 mères de séquence TCT CAC CCA AAT Ag5'.

Un deuxième exemple concerne le greffage d'oligonucléotides présynthétisés. La face libre des moyens de renforcement de fluorescence est traitée par voie chimique pour obtenir dans ce cas une fonction solution d'oligonucléotides Une aldéhyde. comportant une fonction NH₂ en 5' dans un déposée sur le substrat phosphate est conditions permettant la formation d'une liaison le dispositif covalente imine (-CH = N-) entre l'oligonucléotide. Après une nuit d'incubation température ambiante, le dispositif est rincé dans une solution de SDS (dodécylsulfate de sodium) puis dans l'eau. La liaison imine n'étant pas très stable, il est prévu une étape de réduction de la double liaison en présence de Na₂BH₄ pendant 10 minutes. Le dispositif est

à nouveau rincé avec du SDS puis avec de l'eau. Il est ensuite séché sous flux d'azote.

L'étape d'hybridation consiste à mettre en présence, le dispositif comportant les sondes et une solution constituée d'un tampon et de cibles de séquence complémentaire aux sondes comportant un fluorophore CY3 en position 5'. Les d'hybridation permettant l'appariement des sondes et des cibles sont les suivantes :

- solution d'hybridation : 300 μ l de cibles à 0,2 μ M + 900 μ l de tampon d'hybridation H-7140/Sigma,
 - incubation dans une étuve à 40°C pendant 1 heure du dispositif recouvert de la solution,
- rinçage dans un bain de tampon SSC 2X (S- 6639/Sigma) pendant 1 minute,
 - rinçage dans un bain de tampon SSC 0,2X (S-6639/Sigma) pendant 1 minute,
 - séchage sous flux d'azote.

L'observation faite avec un microscope en fluorescence (Olympus BX60) de différents empilements selon l'invention, conduit aux intensités de fluorescence suivantes pour des temps d'intégration de 1 seconde et un objectif 5X (les unités sont exprimées en unité arbitraire UA) :

- Support en Si et monocouche de SiO_2 de 500 nm d'épaisseur déposé par décomposition de tétraéthoxysilane (TEOS), synthèse in situ : 225 UA.
- Support en Si et empilement de couches de SiO_2 et de Si_3N_4 , synthèse in situ : 593 UA. Pour ce type de greffage, le même rapport de renforcement de

fluorescence est obtenu avec une concentration de cibles 4 fois plus faible (0,05 μM au lieu de 0,2 μM).

- Support en Si et monocouche de ${\rm SiO_2}$ de 500 nm d'épaisseur déposé par décomposition de TEOS, oligonucléotides présynthétisés : 140 UA.
- Support en Si et empilement de couches de SiO_2 et de Si_3N_4 , oligonucléotides présynthétisés : 326 UA.
- Il faut noter que l'invention s'applique 10 également à des systèmes de lecture de type scanners confocaux.

L'empilement de couches minces optiques diélectriques permet de vérifier plusieurs points.

- Il est possible d'augmenter le champ d'excitation des fluorophores par rapport à une configuration sans empilement de couches minces. Ceci permet d'augmenter la quantité de lumière émise par les fluorophores. La solution la plus simple consiste à déposer un empilement de type quart d'onde.
- 20 Il est possible d'améliorer la directionnalité de la lumière émise les par fluorophores. Ceci permet d'améliorer la quantité de lumière collectée par le microscope ou le scanner de lecture. Ce n'est pas le cas pour les dispositifs de l'art antérieur. 25

L'emploi de cet empilement, que l'on peut assimiler à un "cristal photonique à une dimension", présente des propriétés de bande interdite qui lui procure un large domaine spectral d'excitation. La longueur d'onde d'excitation peut être choisie sur l'ensemble de la largeur de bande du miroir

30

diélectrique (typiquement > 100 nm). Ceci permet par ailleurs l'emploi simultané de plusieurs fluorophores compatibles avec cette bande spectrale. Ceci n'est pas le cas pour les dispositifs de l'art antérieur.

La propriété précédente a également pour conséquence d'introduire une souplesse sur le choix de l'incidence de la lumière d'excitation. Ceci n'est pas le cas pour les dispositifs de l'art antérieur.

Il est possible d'obtenir un renforcement

du signal en travaillant en incidence normale, dans
l'espace libre sans faire appel à des structures
guidantes. Dans ce cas, l'excitation des fluorophores
du biocapteur est réalisée avec un système non dédié.
L'invention est compatible avec des appareils

commerciaux.

L'invention permet de bloquer la lumière d'excitation dans l'empilement et de limiter la fluorescence parasite venant du substrat.

L'invention permet aussi de ne pas employer 20 de couches minces métalliques dans l'empilement. La présence de ces matériaux provoque l'apparition de pertes non radiatives qui limitent l'efficacité du renforcement de fluorescence.

L'invention propose des empilements de 25 haute qualité optique en termes de pertes absorption. En particulier, on cherche à minimiser l'influence de la dernière couche mince (celle sur laquelle sont déposés les fluorophores). Cette couche est particulièrement optimisée. On cherche à obtenir des coefficients d'extinction les plus faibles possible 30 (indice imaginaire). Typiquement, des coefficients

d'extinction inférieures à 10⁻³ sont requis. Dans ce cas, les pertes non radiatives sont limitées.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de renforcement fluorescence comprenant un support (1, 10) supportant des moyens de renforcement de fluorescence (2, 11), les 5 moyens de renforcement de fluorescence offrant une face de réception pour des éléments chimiques ou biologiques (3) destinés à être lus par détection d'un signal de fluorescence émis par un fluorophore, associé éléments chimiques ou biologiques, sous l'effet d'un 10 faisceau lumineux d'excitation, caractérisé en ce que les moyens de renforcement de fluorescence (2, 11) sont constitués couche par une mince diélectrique transparente ou un empilement de couches 15 diélectriques transparentes (12 à 16) assurant fonction miroir pour le signal de fluorescence et pour le faisceau lumineux d'excitation, le matériau de la couche mince ou de chaque couche mince de l'empilement étant choisi parmi les matériaux suivants : TiO2, Ta2O5, 20 HfO2, ZrO2, MgO, SiO2, Si3N4, MgF2 et YF3.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'épaisseur e de la couche mince (2) ou l'épaisseur de chaque couche mince (12 à 16) de l'empilement est calculée à partir de la formule suivante :

N.e =
$$k.\lambda/4$$

où N est l'indice de réfraction du matériau de couche mince pour la longueur λ du signal de lecture et k est un entier impair.

25

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens de renforcement de fluorescence sont des moyens déposés sur une face structurée du support.

5

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite face de réception est une face offrant des fonctions hydroxyles.

10

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite face de réception est une face offrant des fonctions aldéhydes.

15

20

6. Capteur optique biologique ou chimique constitué par le dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, ladite face de réception supportant des éléments chimiques ou biologiques marqués par un fluorophore.

1 / 1

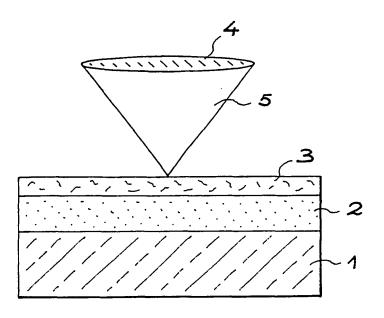


FIG. 1

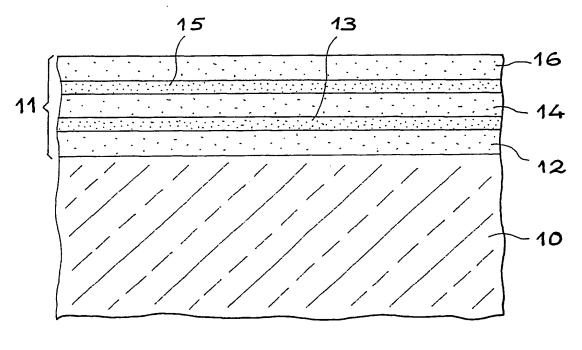


FIG. 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In tional Application No FR 01/03960

	CLACC	IEIC ATIO	MOES	LIB IECT	Λ. 5
Α.	CLASS	IFICA IIC	MOI 3	וטבטבעו	INVESTIGATION
ΤF	ንሮ 7	IFICATIO G01	N21/	′6 4	

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7-601N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal, INSPEC

C. DOCUME	INTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	US 5 552 272 A (BOGART GREGORY R) 3 September 1996 (1996-09-03) column 3, line 24 - line 42 column 3, line 64 -column 4, line 2 column 8, line 49 - line 55 claims 5,23	1,2,6
A	US 5 478 755 A (ATTRIDGE JOHN W ET AL) 26 December 1995 (1995-12-26) claims 1,2	1,6
A	DE 29 46 234 A (ECKERT THEODOR PROF DR;KNIE ULRICH) 27 May 1981 (1981-05-27) claim	1,6

 	
Further documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E* earlier document but published on or after the international filing date L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	 'T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. '&' document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
10 April 2002	18/04/2002
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Krametz, E

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

in Itional Application No

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5552272	Α	03-09-1996	NONE		 _
US 5478755	A	26-12-1995	US	5830766 A	03-11-1998
			ΑT	103394 T	15-04-1994
			ΑU	638938 B2	15-07-1993
			AU	4043389 A	19-02-1990
			CA	1339005 A1	25-03-1997
			DE	68914134 D1	28-04-1994
			DE	68914134 T2	11-08-1994
			EP	0353937 A1	07-02-1990
			EP	0382832 A1	22-08-1990
			ES	2050277 T3	16-05-1994
			WO	9001166 A1	08-02-1990
			JP	2969177 B2	02-11-1999
			JP	3502604 T	13-06-1991
			NO	177407 B	29-05-1995
·			ZA	8905648 A	27-06-1990
DE 2946234	Α	27-05-1981	DE	2946234 A1	27-05-1981

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

D,	de int	ernationale No
	/FR	01/03960

A. CLASSEI	MENT DE L'	OBJET D	DE LA	ANDE
CTR 7	GO1N2	1/64		

Seton la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 GO1N

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)
WPI Data, PAJ, EPO-Internal, INSPEC

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 5 552 272 A (BOGART GREGORY R) 3 septembre 1996 (1996-09-03) colonne 3, ligne 24 - ligne 42 colonne 3, ligne 64 -colonne 4, ligne 2 colonne 8, ligne 49 - ligne 55 revendications 5,23	1,2,6
A	US 5 478 755 A (ATTRIDGE JOHN W ET AL) 26 décembre 1995 (1995-12-26) revendications 1,2	1,6
A	DE 29 46 234 A (ECKERT THEODOR PROF DR;KNIE ULRICH) 27 mai 1981 (1981-05-27) revendication	1,6

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
 'A' document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent 'E' document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date 'L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) 'O' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens 'P' document publié ayant la date de dépôt international, mais 	 *T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention *X* document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément *Y* document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier *&* document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
10 avril 2002	18/04/2002
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2	e Fonctionnaire autorisé
NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Krametz, E

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (juillet 1992)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relat

x membres de familles de brevets

Dt be Internationale No PCT/FR 01/03960

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de famille de brevet(s)		Date de publication
US 5552272	А	A 03-09-1996			
US 5478755	Α	26-12-1995	US	5830766 A	03-11-1998
			ΑT	103394 T	15-04-1994
			ΑU	638938 B2	15-07-1993
			AU	4043389 A	19-02-1990
			CA	1339005 A1	25-03-1997
			DΕ	68914134 D1	28-04-1994
			DE	68914134 T2	11-08-1994
			EP	0353937 A1	07-02-1990
			EP	0382832 A1	22-08-1990
			ES	2050277 T3	16-05-1994
			WO	9001166 A1	08-02-1990
			JP	2969177 B2	02-11-1999
			JP	3502604 T	13-06-1991
			NO	177407 B	29-05-1995
			ZA	8905648 A	27-06-1990
DE 2946234	Α	27-05-1981	DE	2946234 A1	27-05-1981